

- [1] Абдуллин Э.И., Баженов Г.П., Ким А.А., Ковальчук Б.М., Кокшенов В.А. - Физика плазмы, 1986, т. 12, № 10, с. 1260-1264.
- [2] Голованов Ю.П., Долгачев Г.И., Зака-тов Л.П., Скорюшин В.А. - Физика плазмы, 1988, т. 14, в. 7, с. 880-885.
- [3] Kania D.R., Jones L.A., Zimmerman E.L., Veese R.L. and Trainor R.J. - Appl. Phys. Lett., 1984, 44(8), p.741-743.
- [4] Meger R.A., Commisso R.J., Cooperstein G., and Shyke A. Goldstein. - Appl. Phys. Lett., 1983, 42(11), p.943-945.
- [5] Ottinger P.F., Goldstein S.A. and Meger R.A. - J. Appl. Phys., 1984, 56(3), p.774-784

Поступило в Редакцию  
4 ноября 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 24

26 декабря 1988 г.

### ТЕРМОГРАДИЕНТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СВОБОДНОЙ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ КАПИЛЛЯРНЫХ ВОЛН

А.А. У г л о в, С.В. С е л и ш е в

Температурный градиент ( $\beta$ ) вблизи свободной плоской поверхности жидкости может являться причиной ее неустойчивости к возникновению капиллярных волн [1-3]. Для реализации конкретного механизма неустойчивости существенное значение имеет знак  $\beta$  при  $z \rightarrow 0$ , где начало координат находится на невозмущенной свободной поверхности жидкости, а ось  $z$  направлена из жидкости в газовую среду. В [1] для развития неустойчивости необходимо  $\beta > 0$ , в [2]  $\beta < 0$ . В [3] неустойчивость, приводящая к возникновению капиллярных волн, развивается при  $\beta > 0$ , а при  $\beta < 0$  развивается апериодическая неустойчивость.

Важное, в том числе и для практических приложений [4], общее свойство механизмов этих неустойчивостей заключается в том, что для их развития величина  $\beta$  должна быть достаточно большой. Казалось бы, что при дальнейшем закритическом увеличении  $\beta$  неустойчивость должна развиваться интенсивней. Однако, как показано в данной работе, при достаточно большом  $\beta$  вне зависимости от его знака и числа Прандтля ( $Pr$ ) жидкости ее свободная плоская поверхность всегда устойчива к возникновению капиллярных волн.

Используя [1-3], рассмотрим граничные условия на свободной плоской поверхности жидкости:

$$\frac{\partial h}{\partial t} - v = 0, \quad (1)$$

$$\sigma \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \rho - 2\eta \frac{\partial v}{\partial z} = 0, \quad (2)$$

$$-\frac{\partial \sigma}{\partial T} \frac{\partial \theta}{\partial x} - \frac{\partial h}{\partial x} \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial T} \cdot \beta + \eta \left( \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} = 0, \quad (4)$$

где  $t$  - время,  $h$  - возмущение поверхности жидкости,  $v$  - возмущение нормальной компоненты скорости жидкости,  $w$  - тангенциальной,  $\sigma$  - коэффициент поверхностного натяжения жидкости,  $\eta$  - ее вязкость,  $x$  - координата вдоль плоской поверхности жидкости,  $\rho$  - возмущение давления жидкости,  $\theta$  - возмущение температурного поля ( $T$ ) жидкости,  $\beta = \partial T / \partial z$ .

Возмущение температурного поля жидкости определяется уравнением

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = -v\beta + g \left( \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} \right), \quad (5)$$

а возмущение поля скоростей

$$\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} = 0, \quad (6)$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\eta}{\rho} \left( \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right), \quad (7)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial z} + \frac{\eta}{\rho} \left( \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right), \quad (8)$$

где  $g$  - коэффициент температуропроводности жидкости,  $\rho$  - ее плотность. Кроме того, считаем, что

$$v = w = \theta = 0 \quad \text{при} \quad z \rightarrow -\infty. \quad (9)$$

Из (5)-(9) следует

$$v = \exp(i\omega t - imx) \left[ N_1 \exp(-i\mu_1 z) + N_2 \exp(-i\mu_2 z) \right], \quad (10)$$

$$m > 0, \quad \mu_1 = im, \quad i\omega = -\frac{\eta}{\rho} (\mu_2^2 + m^2), \quad (11)$$

$$\theta = \exp(i\omega t - imx) \left[ N_3 \exp(-i\mu_3 z) - \frac{\beta}{i\omega} (N_1 \exp(-i\mu_1 z) + \frac{P_T}{P_T - 1} N_2 \exp(-i\mu_2 z)) \right], \quad (12)$$

$$i\omega = -g(\mu_3^2 + m^2), \quad (13)$$

где  $m$  — волновое число для возмущений вдоль поверхности жидкости, слагаемое  $\sim N_1$  соответствует потенциальным возмущениям поля скоростей жидкости,  $N_2$  — вихревым. Слагаемое  $\sim N_3$  соответствует возмущениям температурного поля жидкости, обусловленных теплопроводностью.

Пренебрегая вязкостью, что уменьшает устойчивость системы, в балансах нормальных (2) и тангенциальных (3) напряжений из (1), (2) получаем дисперсионное уравнение для капиллярных волн

$$\omega^2 = \omega_0^2(1+a), \quad \omega_0^2 = Gm^3/\rho, \quad (14)$$

$$a = \frac{im(P_T - 1)}{\mu_3 - P_T \mu_2}. \quad (15)$$

Используя (11), (13), преобразуем (15)

$$a = \frac{im(\mu_3 + P_T \mu_2)}{P_T m^2 - \mu_3^2}. \quad (16)$$

Решение, близкое к  $\mu_3 \approx \pm m\sqrt{P_T}$ , не удовлетворяет условию локализации возмущений (9). Поэтому знаменатель (16) всегда отличен от нуля.

Из (11), (13) следует, что неустойчивость в рассматриваемой системе может развиваться при условии  $|\mu_2|, |\mu_3| \gtrsim m$ . Пусть выполняется более сильное условие  $|\mu_2|, |\mu_3| \gg m$ . Тогда  $|a| \ll 1$ , и для решения (14) можно использовать метод возмущений:  $\omega \approx \omega_0(1+a/2)$ .

Полагая для определенности  $\omega_0 > 0$ , из (11), (13) имеем

$$\mu_2 \approx (-1+i)\sqrt{\frac{\rho}{2\eta}\omega_0}, \quad \mu_3 \approx (-1+i)\sqrt{\frac{\omega_0}{2g}}. \quad (17)$$

Подставляя (17) в (16), имеем  $\text{Im}a > 0$ , что определяет устойчивость плоской поверхности жидкости к возникновению капиллярных волн.

Для полученной устойчивости существенное значение имеет учет в (3) тангенциальных напряжений, связанных с возмущениями поверхности жидкости. Их отсутствие, как принято, например, в [3], приводит к прямо противоположному результату. Таким образом, при анализе изменений рельефа поверхности, связанного с термокапиллярными явлениями, важно учитывать в (3), как это сделано в [1, 2], слагаемое  $\sim \rho \partial h / \partial x$ .

Учет вязкости в (2), (3), как показывает анализ дисперсионного уравнения, приводит к повышению устойчивости рассматриваемой системы.

Таким образом, температурный градиент вблизи свободной плоской поверхности жидкости может являться как дестабилизирующим систему фактором [1-3], так и стабилизирующим.

## Л и т е р а т у р а

- [1] P a l m e r Н.У. — У. Fluid.Mech., 1976, v. 75, N 3, p. 487-511.
- [2] Л е в ч е н к о Е.Б., Ч е р н я к о в А.Л. — ЖЭТФ, 1980, т. 78, с. 1597-1608.
- [3] Б у г а е в А.А., Л у к о ш к и н В.А., Я к о в л е в Д.Г. — ЖТФ, 1988, т. 58, № 5, с. 908-914.
- [4] Р ы к а л и н Н.Н., У г л о в А.А., З у е в И.В., К о к о р а А.Н. Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов. М.: Машиностроение, 1985. 496 с.

Поступило в Редакцию  
7 ноября 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 24

26 декабря 1988 г.

ОТЖИГ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ ПАР ФРЕНКЕЛЯ В  $p$ -Ge,  
ОБЛУЧЕННОМ ЭЛЕКТРОНАМИ С ЭНЕРГИЕЙ  
0.6 МэВ И 1.2 МэВ

А.Н. К р а й ч и н с к и й, Л.В. М и з р у х и н,  
И.С. Р о г у ц к и й, В.И. Ш а х о в ц о в

В [1-11] установлено, что центрированная при  $T=65$  К стадия изохронного отжига проводимости кристаллов  $p$ -Ge, облученных электронами с энергией  $\sim 1$  МэВ при гелиевых температурах, обусловлена аннигиляцией „замороженных“ генетически связанных пар вакансия (У)-межузельный атом (I), получивших название метастабильных пар Френкеля (МПФ). Важным свойством МПФ (радиационных акцепторов) является сдвиг их стадии отжига в область гелиевых температур при облучении „допороговыми“ электронами 0.3-0.5 МэВ ( $T_{отж}=5-7$  К [4, 8]) или светом с энергией кванта  $h\nu < E_G$  ( $E_G$  — ширина запрещенной зоны,  $T_{отж}=4.2$  К [3, 8]). В условиях ионизации кристаллов при подсветке „допороговой“ радиацией или светом процесс отжига МПФ характеризуется аномально малым значением энергии активации (4-5 МэВ [4, 8]) и диффузионно-контролируемым движением I к У [4]. Механизм миграции I в неравновесных условиях предложен в [12, 13] и основан на инверсии потенциала для I в процессе перезарядок  $I^0 \rightarrow I^+ \rightarrow \dots$